



nexthardware.com

a cura di: Gian Paolo Collalto - giampa - 06-08-2013 15:30

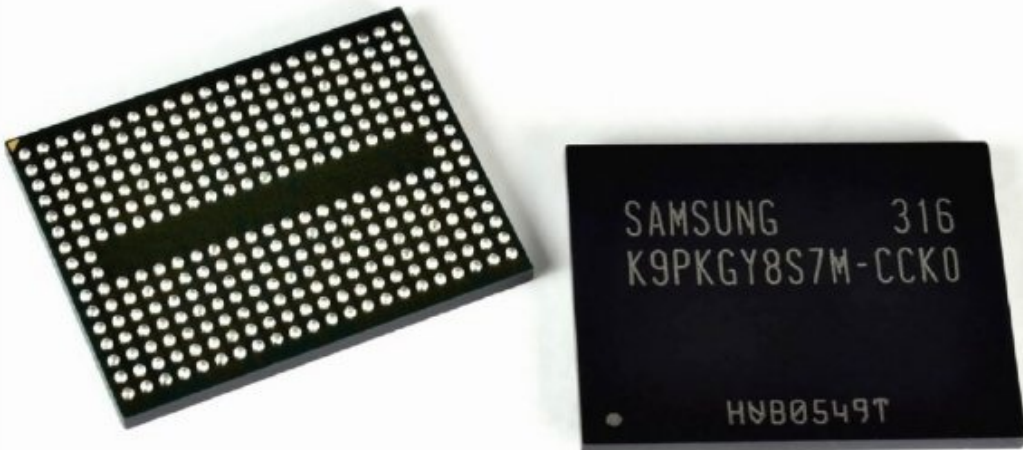
3D Vertical NAND Flash, la prima è Samsung

...



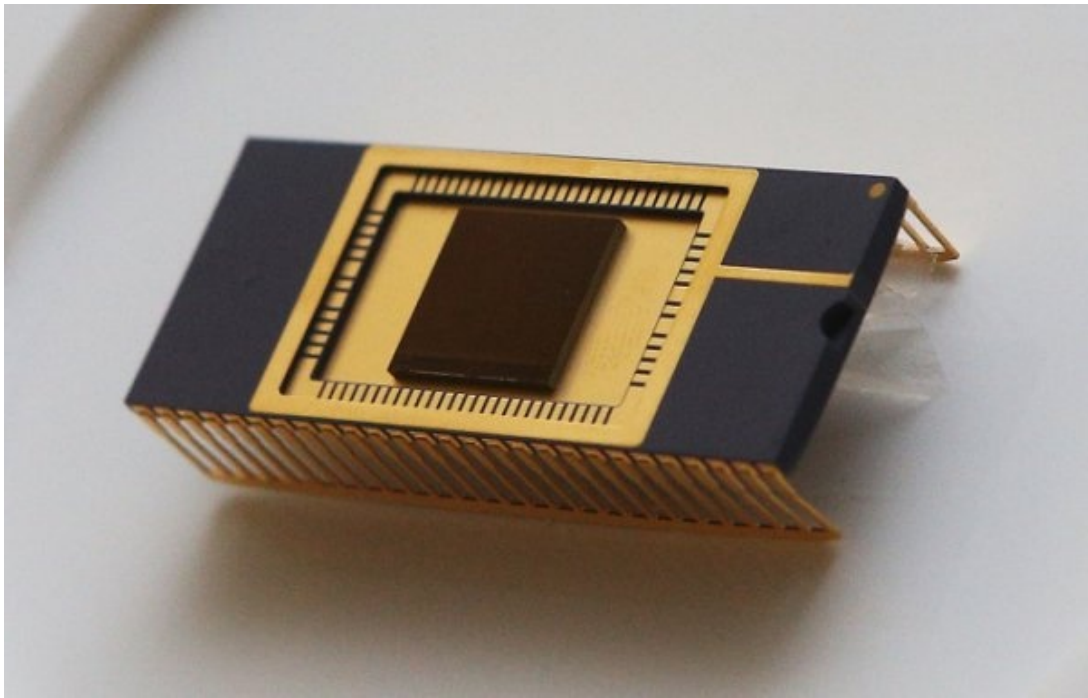
LINK (<https://www.nexthardware.com/news/ram-memorie-flash/5590/3d-vertical-nand-flash-la-prima-e-samsung-.htm>)

Annunciato l'inizio della produzione di massa delle nuove NAND destinate agli SSD e ai dispositivi mobili di nuova generazione.



Samsung Electronics ha annunciato oggi di aver iniziato la produzione su larga scala delle 3D Vertical NAND Flash, le prime NAND con processo produttivo tridimensionale che rivoluzioneranno in breve tempo il mercato dell'elettronica di consumo e non solo.

Le nuove Samsung V-NAND offrono una densità 128 Gb per singolo chip, utilizzando una struttura di interconnessione delle celle a sviluppo verticale, basata sulla tecnologia proprietaria "3D Charge Trap Flash" (CTF), il che si traduce in una maggiore densità e capacità di archiviazione delle stesse rispetto alle attuali soluzioni "planari" a 20nm.



Questa nuova architettura aggira gli attuali limiti sull'affidabilità e le difficoltà produttive di celle con processo produttivo a 10nm, prevedendo che la carica sia temporaneamente parcheggiata in una camera composta da uno strato non conduttivo di nitruro di silicio (SiN), al posto del tradizionale gate polisiliconico di tipo flottante (floating gate), evitando così interferenze con le altre celle.

Non ci sarà da stupirsi, quindi, di vedere a breve sul mercato SSD o smartphone con capacità di archiviazione più che raddoppiate a prezzi abbordabili.